



## ТРАНЗИСТОРЫ ТИПА КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И, КТ315Н

### ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п транзисторы типа КТ315А...Н в пластмассовом корпусе изготавливаются для нужд народного хозяйства. Транзисторы КТ315Н предназначены для применения только в цветном телевидении. Вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1;1.2;2;3;3.1;5.1

#### Схема расположения выводов



Наличие точки в составе маркировки является отличительным знаком транзисторов, предназначенных для цветного телевидения: допускается применение в другой аппаратуре.

Основные электрические параметры при температуре  $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Тип транзистора	Норма		Примечание
		не менее	не более	
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА, (при сопротивлении в цепи эмиттер-база $R_{БЭ} = 10\text{кОм}$ )	КТ315А		0,6	
	КТ315Б,Н		0,6	
	КТ315В		0,6	
	КТ315Г		0,6	
	КТ315Д		1,0	
	КТ315Е		1,0	
Обратный ток коллектор-эмиттер, при коротко замкнутых выводах эмиттера и базы, мА, $U_{К} = 20\text{В}$ $U_{Б} = 60\text{В}$	КТ315Ж		0,01	
	КТ315И		0,1	

25

Основные электрические параметры при температуре  $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Тип транзистора	Норма		Примечание
		не менее	не более	
Обратный ток коллектора, мкА, ( $U_k = 10\text{В}$ )	КТ315А...Г,Н		0,5	
	КТ315Д,Е,Ж,И		0,6	
Обратный ток эмиттера, мкА, ( $U_\epsilon = 5\text{В}$ )	КТ315А...Ж,Н		30	
	КТ315И		50	
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора ( $U_k = 10\text{В}$ , $I_\epsilon = 1\text{мА}$ )	КТ315А,В	30	120	
	КТ315Б,Г,Е,Н	50	350	
	КТ315Д	20	90	
	КТ315Ж	30	250	
	КТ315И	30	—	
Модуль коэффициента передачи тока биполярного транзистора на высокой частоте ( $U_k = 10\text{В}$ , $I_\epsilon = 5\text{мА}$ , $f = 20\text{МГц}$ )	КТ315А...Н	12,5	1	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ( $I_k = 20\text{мА}$ , $I_\epsilon = 2\text{мА}$ ) ( $I_k = 20\text{мА}$ , $I_\epsilon = 3,5\text{мА}$ )	КТ315А...Г		0,4	
	КТ315Д,Е		0,6	
	КТ315Ж		0,5	
	КТ315И		0,9	
	КТ315Н		0,4	
Напряжение насыщения база-эмиттер, В, ( $I_k = 20\text{мА}$ , $I_\epsilon = 2\text{мА}$ )	КТ315А...Г,Н		1,0	
	КТ315Д,Е		1,1	
	КТ315Ж		0,9	
	КТ315И		1,35	
Граничное напряжение биполярного транзистора, В, ( $I_\epsilon = 5\text{мА}$ )	КТ315А,Б,Ж,Н	15		
	КТ315В,Д,И	30		
	КТ315Г,Е	25		

Примечание. 1. Для КТ315Ж, КТ315И величина параметра гарантируется предприятием изготовителем

Содержание драгоценных металлов в 1000 штук транзисторов:

золото **70,900** мг.

Цветных металлов не содержится

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов КТ315А...Н соответствуют техническим условиям ЖКЗ.365.200 ТУ

МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА ОТК



Заказ 512—40.000